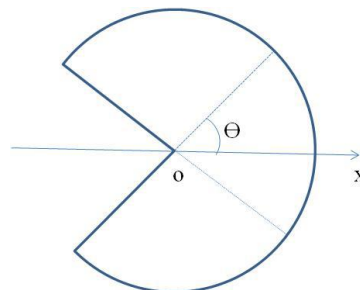


静电场

第一节 库仑定律 电场强度 (p61-62)

1、B; 2、C; 3、B; 4、 $E_A = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}; E_B = \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}; E_C = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 5、0;

6、6. 解：由对称性可知，在圆环上截掉长为 l 一段后，在圆心处产生的电场强度 \vec{E}_1 等于截掉那段导线 l 在圆心处产生的电场强度 \vec{E}_2 的负值。



因为 $l \ll R$ ，所以导线 l 可看作点电荷，

其在圆心处产生的场强为：

$$\vec{E}_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{i} = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{i} \quad \text{方向：} +x \text{ 方向}$$

所以，截掉 l 一段后的圆环在圆心处产生的电场强度：

$$\vec{E}_1 = -\vec{E}_2 = -\frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{i} \quad \text{方向：} -x \text{ 方向}$$

7、解：单位长度上的电量为 $\lambda_1 = \frac{Q}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2Q}{\pi R}, \lambda_2 = -\frac{Q}{\frac{1}{2}\pi R} = -\frac{2Q}{\pi R}$,

$$\begin{aligned} +Q \text{ 部分, } d\vec{E}_+ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_1 dl}{R^2} (\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) \\ &= \frac{Q d\theta}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} (\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}) \end{aligned}$$

$$\text{同理, } -Q \text{ 部分, } d\vec{E}_- = \frac{Q d\theta}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} (-\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j})$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_+ + d\vec{E}_- = -\frac{Q \sin\theta d\theta}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \hat{j}$$

$$\vec{E} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\vec{E} = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Q \sin\theta d\theta}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \hat{j} = -\frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \hat{j}$$

第二节 电通量 高斯定律 (p63-64)

1、C; 2、A; 3、B; 4、 $\pi R^2 E$

5、解：以 o 为球心， r 为半径作一同心球面作为高斯面，

$$r < R_1, \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot dS = 0, E = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_1}{\epsilon_0}, E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > R_2, \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0}, E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

6、解：以轴为中心，以 r 为半径，作高为 1 的同心圆柱面作为高斯面。

$$\text{由高斯定理 } \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} \text{ 得 } \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l E = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$\text{当 } r > R_2 \text{ 时, } Q_{in} = (\lambda_1 + \lambda_2)l, E = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$

7、(1) 取同心球面为高斯面，由高斯定理求 E

$$r \leq R: E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{3Q}{\pi R^3} \left(1 - \frac{r'}{R}\right) 4\pi r'^2 \cdot dr'$$

$$E = \frac{\rho_0 r (4R - 3r)}{12\epsilon_0 R} = \frac{Qr(4R - 3r)}{4\pi\epsilon_0 R^4}$$

$$r > R: E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \frac{3Q}{\pi R^3} \left(1 - \frac{r'}{R}\right) 4\pi r'^2 \cdot dr'$$

$$E = \frac{\rho_0 R^3}{12\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(2) \frac{dE}{dr} = 0 \Rightarrow r = \frac{2}{3}R \text{ 时, } E = E_{\max} = \frac{\rho_0 R}{9\epsilon_0} = \frac{Q}{3\pi\epsilon_0 R^2}$$

8、解：以 x 轴为轴线，r 为半径，作一个圆柱面作为高斯面，圆柱面的上下底面距离原点 0 距离为 x。

$$\text{由高斯定理 } \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} \text{ 得 } \Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r^2 E = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$\text{当 } x < \frac{d}{2} \text{ 时, } Q_{in} = \pi r^2 \cdot 2x\rho, E = \frac{1}{2\pi r^2} \pi r^2 \cdot 2x\rho = \frac{x\rho}{\epsilon_0}$$

$$\text{当 } x \geq \frac{d}{2} \text{ 时, } Q_{in} = \pi r^2 \cdot d\rho, E = \frac{1}{2\pi r^2} \pi r^2 d\rho = \frac{d\rho}{2\epsilon_0}$$

第三节 电势 电势能 (p65-66)

$$1、C; 2、D; 3、\frac{3\sqrt{3}q}{2\pi\epsilon_0 a}; 4、\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, 0; \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}; 5、>, >;$$

6、解：由高斯定理可知，空间各处电场分布为：

$$r < R_1, E = 0$$

$$R_1 < r < R_2, E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r > R_2, E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

r 处的电势和该处电场的关系为： $V = \int_r^\infty E dr$

$$r < R_1, V = \int_r^{R_1} E dr + \int_{R_1}^{R_2} E dr + \int_{R_2}^\infty E dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$R_1 < r < R_2, V = \int_r^{R_2} E dr + \int_{R_2}^\infty E dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$r > R_2, V = \int_r^\infty E dr = \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

7、解：法一：以场源所在位置为原点，水平向右为正方向，建立直角坐标系，设想将单位正电荷从 M 点移到 P 点，电场力做功为

$$W_{MP} = \varphi_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{2a}^a \frac{q}{x^2} dx = -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$$

法二：以无限远的位置为零势能点， $V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2a}$, $V_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$

以 P 点为零势能点， $V_{MP} = V_M - V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{2a} - \frac{q}{a} \right) = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$

8、解：在圆环上取一微元 dl，所带电量为 dq = λdl，

dq 在 P 点处产生的电势为 $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{\sqrt{a^2 + R^2}}$ ，

电势为 $V = \int dV = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{\sqrt{a^2 + R^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R \lambda}{\sqrt{a^2 + R^2}} = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R \lambda}{\sqrt{a^2 + R^2}}$

电场力所做的功为

$$W = -\Delta E_p = q(V_a - V_b) = q \left(\frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R \lambda}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R \lambda}{\sqrt{b^2 + R^2}} \right) = \frac{q R \lambda}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2 + R^2}} \right)$$